

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成25年7月25日(2013.7.25)

【公表番号】特表2012-532251(P2012-532251A)

【公表日】平成24年12月13日(2012.12.13)

【年通号数】公開・登録公報2012-053

【出願番号】特願2012-517609(P2012-517609)

【国際特許分類】

<i>B</i> 2 2 F	1/00	(2006.01)
<i>H</i> 0 1 M	4/38	(2006.01)
<i>H</i> 0 1 M	4/134	(2010.01)
<i>H</i> 0 1 M	4/1395	(2010.01)
<i>B</i> 8 2 Y	40/00	(2011.01)
<i>B</i> 2 2 F	9/04	(2006.01)
<i>C</i> 2 2 C	45/02	(2006.01)
<i>C</i> 2 2 C	45/04	(2006.01)

【F I】

<i>B</i> 2 2 F	1/00	E
<i>H</i> 0 1 M	4/38	Z
<i>H</i> 0 1 M	4/02	1 0 5
<i>H</i> 0 1 M	4/02	1 1 2
<i>B</i> 8 2 Y	40/00	
<i>B</i> 2 2 F	9/04	C
<i>C</i> 2 2 C	45/02	Z
<i>C</i> 2 2 C	45/04	Z

【手続補正書】

【提出日】平成25年6月4日(2013.6.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

シリコンを実質的に含有しない、ナノ構造の合金粒子を作製する方法であって、ミリング媒体を含有するペブルミル内で、ミルベースをミリングし、前記ナノ構造の合金粒子を用意する工程であって、前記ミルベースが、スズと、炭素又は遷移金属のうちの少なくとも1つとを含み、前記ナノ構造の合金粒子が、寸法が50ナノメートルを超える結晶性ドメインを実質的に含まない、工程を含む、方法。

【請求項2】

リチウムイオン電気化学セルのための負電極を作製する方法であって、ペブルミル内でミルベースをミリングする工程であって、前記ミルベースが、スズと、

炭素又は遷移金属のうちの少なくとも1つとを含み、前記ナノ構造の合金粒子が、寸法が50ナノメートルを超える結晶性ドメインを実質的に含まない、工程と、

前記ナノ構造の合金粒子を、ポリマー結合剤を含むスラリー中に分散させる工程と、前記スラリーを金属カレントコレクタ上にコーティングする工程と、を含む、方法。